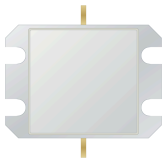
2700–3500 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — PSAT 53.5 dBm (típico)

LCT-2700-3500-PS53p5T · 2700–3500 MHz · GaN Transistor de potencia con adaptación interna.



Valores de la tabla RF: PSAT 53.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 13.5 dB (típico); PAE 65 % (típico). Condiciones de ensayo RF: TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs.

CMW025B

Aplicar primero la polarización de puerta y después la de drenador. Al apagar, retirar primero la de drenador.

Vg: C = 10 µF

Características RF

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Frecuencia de funcionamiento	f	2700	-	3500	MHz
Potencia de salida saturada	-	53	53.5	-	dBm
Ganancia de potencia	-	13	13.5	-	dB
Eficiencia de potencia añadida	-	60	65	-	%
Planitud de la ganancia de potencia	-	-	-	1.5	dB

Polarización DC y corrientes

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidad
Tensión de drenador en funcionamiento	-	-	-	-	28	V
Tensión de puerta en funcionamiento	-	-	-	-	[-4, -2]	V
Tensión de estrangulamiento	-	-4	-	-2	VDS = 6 V; IDS ≤ 80 mA	V
Corriente inversa de puerta	-	-	-	0.01	VDS = 0 V; VGS = -10 V	A

Valores límite

Valores límite; no son consignas de funcionamiento normal.

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Tensión drenador-fuente máxima	-	-	-	32	V
Polarización de puerta mínima	-	-5	-	-	V
Temperatura de almacenamiento	-	-65	-	150	°C
Potencia de entrada máxima	-	-	-	42	dBm

Registro de la publicación actual · 1.6 · 2026-11-12. Actualización de la descripción o del contenido editorial. Sustituye a la revisión 1.5.

Notas de integración

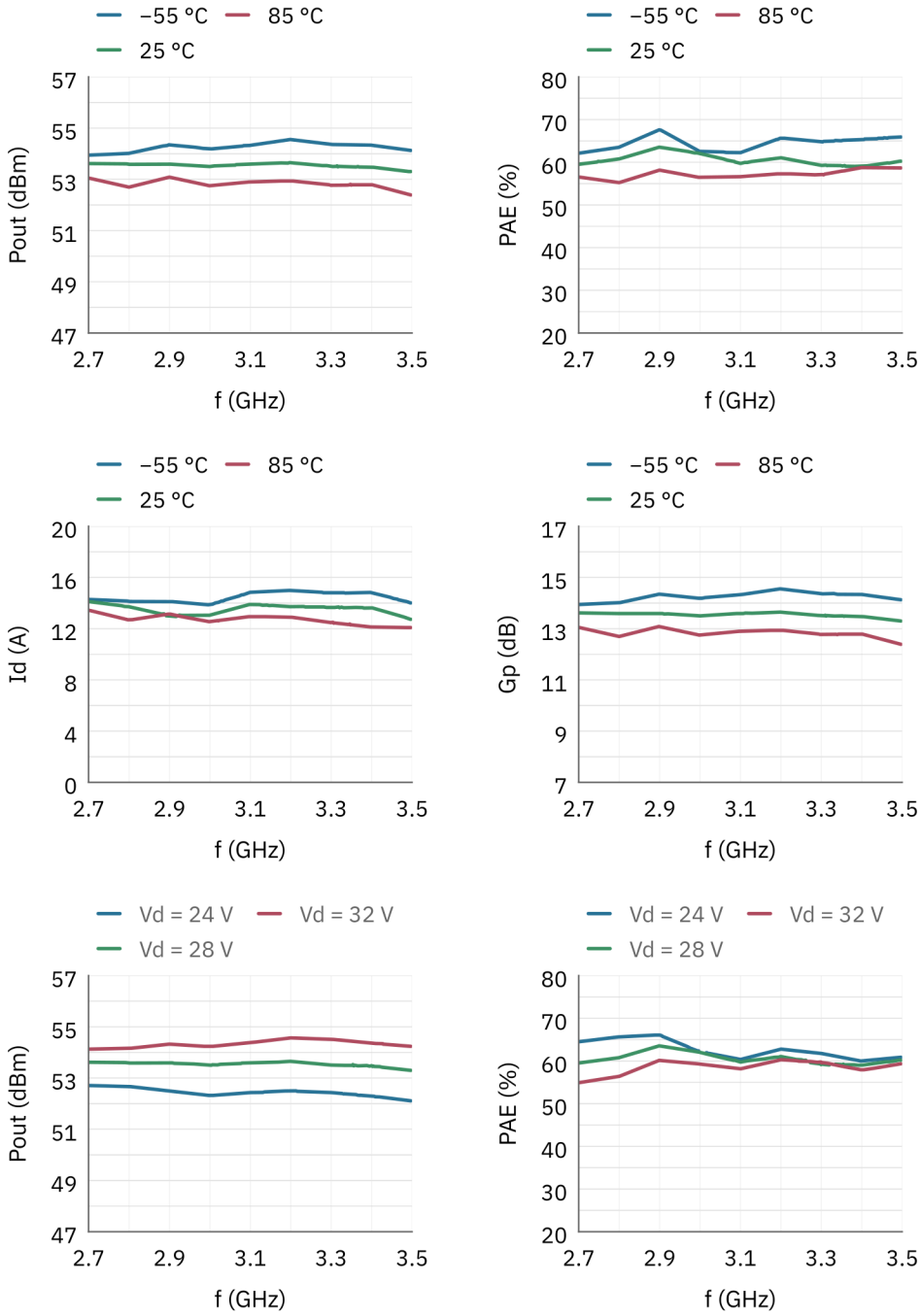
CMW025B Aplicar primero la polarización de puerta y después la de drenador. Al apagar, retirar primero la de drenador. Vg: C = 10 µF G: Entrada RF D: Salida RF S: Fuente / tierra

Curvas de rendimiento

Consultar cada figura junto con las condiciones de funcionamiento indicadas.

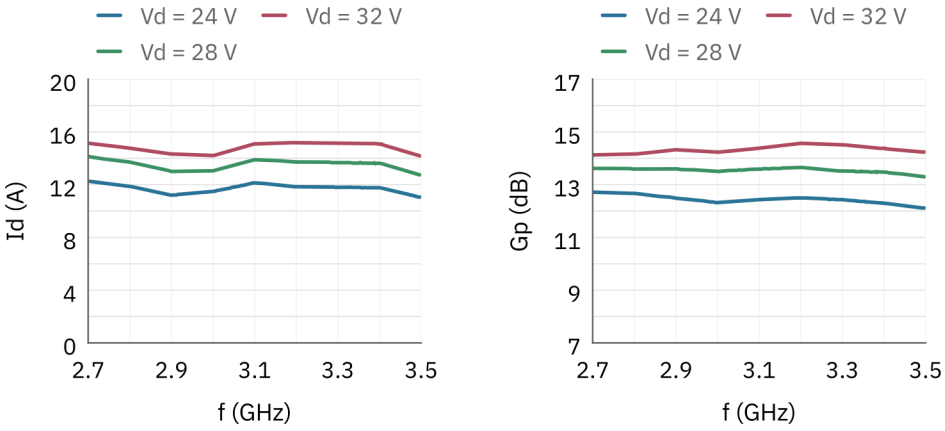
Potencia de salida; Eficiencia de potencia añadida; Corriente de drenador; Ganancia de potencia.

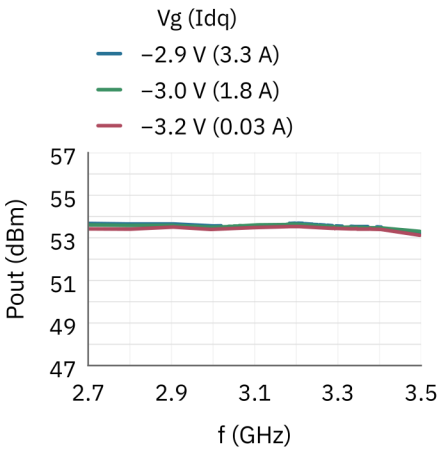
Las lecturas son aproximadas. Pout / PAE / Id / Gp: T = −55 / +25 / +85 °C; Vd = 28 V; Vg = −3 V; Pin = 40 dBm; PW = 100 µs; D = 10%.
Pout / PAE (Vd): Vd = 24 / 28 / 32 V; TA = +25 °C; Vg = −3 V; Pin = 40 dBm; PW = 100 µs; D = 10%.

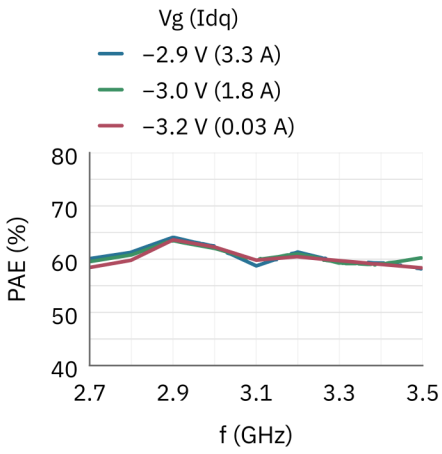


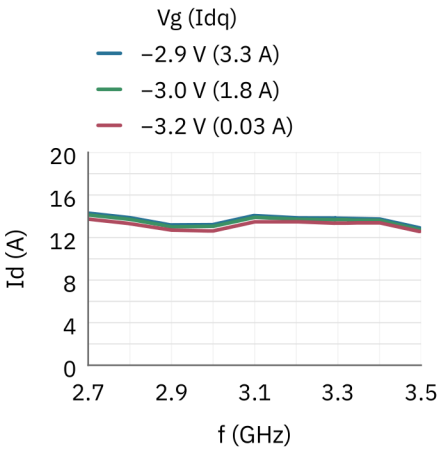
Potencia de salida; Eficiencia de potencia añadida; Corriente de drenador; Ganancia de potencia.

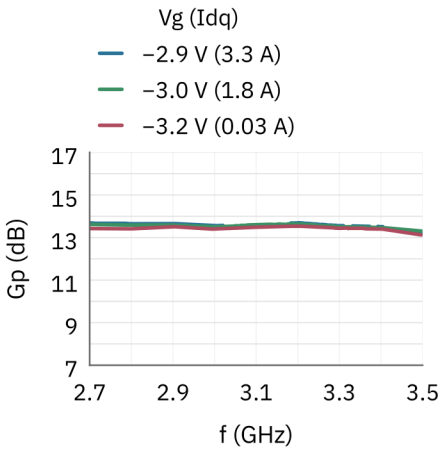
Las lecturas son aproximadas. Id / Gp (Vd): Vd = 24 / 28 / 32 V; Vg = −3 V. Pout / PAE / Id / Gp (Vg): Vg = −2.9 / −3.0 / −3.2 V; Idq = 3.3 / 1.8 / 0.03 A; Vd = 28 V. TA = +25 °C; Pin = 40 dBm; PW = 100 µs; D = 10%.





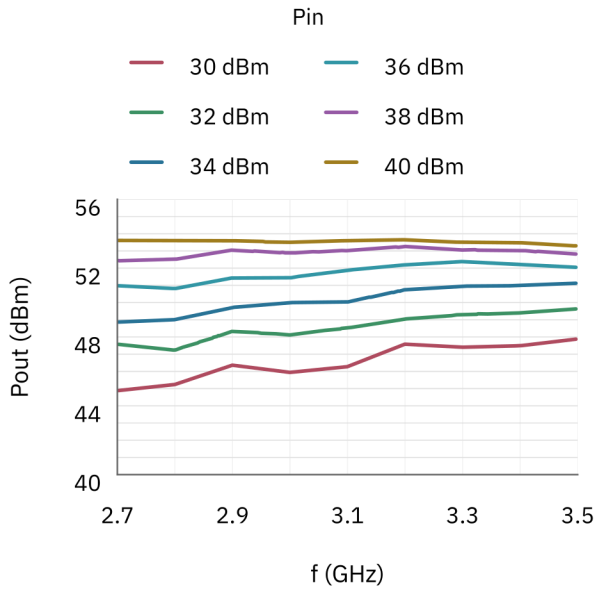


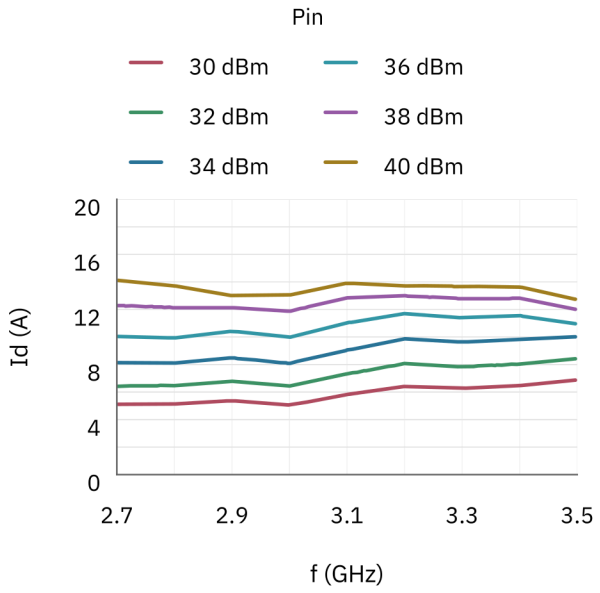


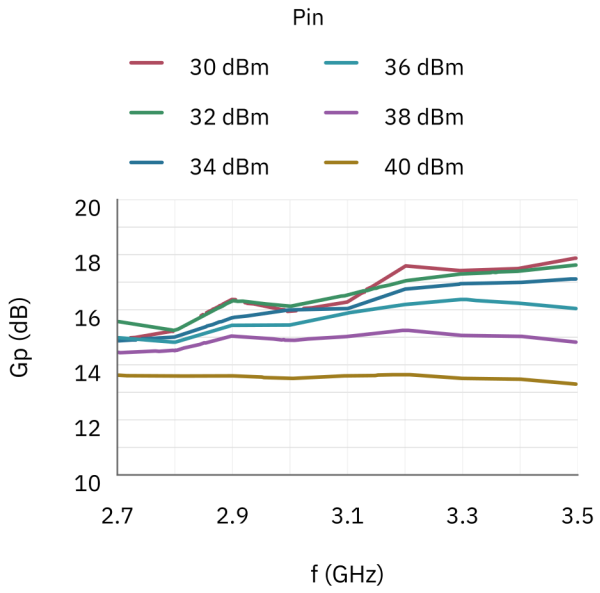


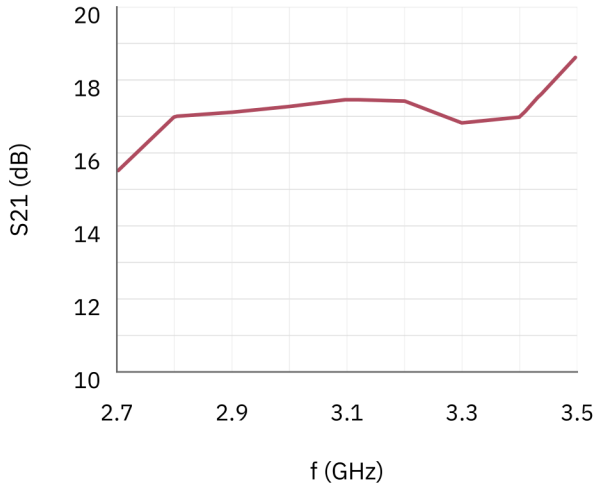
Pout (dBm); Id (A); Gp (dB); S21 (dB).

Las lecturas son aproximadas. Pout / Id / Gp: Pin = 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 dBm; Vd = 28 V; Vg = −3 V; TA = +25 °C; PW = 100 µs; D = 10%. Estas condiciones de polarización, excitación e impulso solo corresponden a Pout/Id/Gp. La última gráfica S21 no indica condiciones propias de polarización, Pin ni impulso.









Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.